

6 ИЗДЕЛИЯ В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ ОСВОЕНИЯ

6.10 Модуль полупроводниковый силовой на основе IGBT и диодах Шоттки МТКИ2-600-2

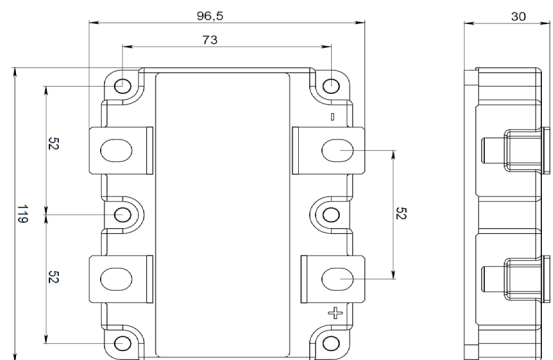
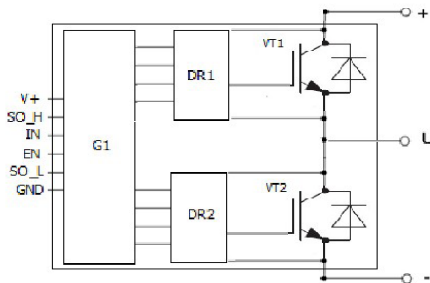
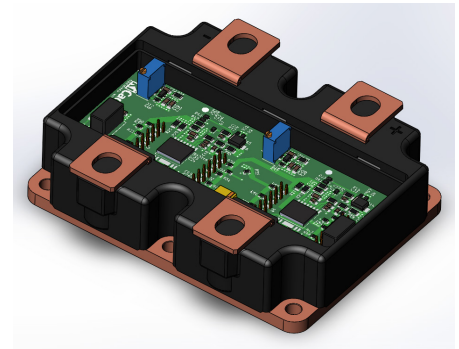
• ДФЛК.435700.001ТУ

Модуль предназначен для работы в установках оснащенных бесколлекторными двигателями как, в режиме силового инвертора, так и в режиме выпрямителя.

Модуль состоит из транзисторов с малыми статическими потерями и диодов Шоттки с низким падением, что позволяет получить высокие характеристики в режиме инвертора и выпрямителя.

Модуль оснащен интегрированным драйвером силовых ключей, установленным непосредственно в конструктив модуля.

Предусмотрена установка термистора для контроля температуры основания модуля.



Параметр	Буквенное обозначение	Значение
Максимально допустимое постоянное напряжение, В	$U_{кэ\ max}$	200
Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-эмиттер транзистора, В	$U_{зэ\ max}$	± 20
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{к\ max}$	600 ¹
Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А	$I_{к(и)\ max}$	1800 ¹
Напряжение коллектор-эмиттер в открытом состоянии ($I_{пр} = 600\ A$), В	$U_{кэ}$	1.9 ¹
Постоянное прямое напряжение диода, В ($I_{пр} = 600\ A$)	$U_{пр}$	$\leq 0,9^1$
Постоянный обратный ток диода, мА ($U_{обр} = 200\ В$)	$I_{обр}$	$\leq 1,0^1$
Максимально допустимый постоянный ток диода, А	$I_{ЭК\ max}$	600 ^{1,2,3}
Максимально допустимый импульсный ток диода, А	$I_{ЭК(и)\ max}$	1800
Примечания		
1. При температуре корпуса 25°C.		
2. При температуре корпуса 85°C.		
3. При температуре корпуса -60°C.		